



ナノテクノロジーフォーラムよりのお知らせ

ナノエレクトロニクス集積化・応用技術調査専門委員会開催のご案内

来る7月13日に弊学ナノ理工学研究機構共催の研究会「テーマ:最先端メモリ技術」を開催します。
ご興味ある方は是非ご参加ください。

【参加申込:7月12日締切】

ナノテクノロジーフォーラム事務局(nano-forum@list.waseda.jp)宛てにお名前・ご所属・連絡先をご連絡ください。

— 記 —

電気学会 ナノエレクトロニクス集積化・応用技術調査専門委員会

◆◆◆ 最先端メモリ技術 ◆◆◆

日時:平成24年7月13日(金) 14:00 - 17:20

会場:〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町513
早稲田大学研究開発センター120-5号館
先端科学・健康医療融合研究機構(ASMeW)1階会議室
<http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html>
(東京メトロ東西線「早稲田駅」3a出口徒歩3分)

共催:電気学会 クラウド時代のユビキタス電子デバイス調査専門委員会
早稲田大学ナノ理工学研究機構
電気学会 ナノエレクトロニクス集積化・応用技術調査専門委員会

参加費:無料

【プログラム】

- 14:00-14:10 開会の挨拶
- 14:10-14:50 「3次元NANDフラッシュメモリ技術」
青地 英明様(東芝)
- 14:50-15:30 「デバイス信頼性物理からのチャレンジ」
劉 紫園様(ルネサスエレクトロニクス)
- 15:30-15:50 休憩
- 15:50-16:30 「SSDとストレージ・クラス・メモリを用いたメモリシステム」
竹内 健様(中央大学)
- 16:30-17:10 「ノーマリーオフコンピュータのための不揮発性
ワークメモリ:MRAMからスピンRAMへ」
安藤功兒(産総研)
- 17:10-17:20 閉会の挨拶

* 終了後に場所を変えて懇親会を開催いたしますので、ぜひご出席ください。

<<本件担当幹事>>: 昌原 明植(産総研)